文章编号:1000-6281(2005)06-0547-04

# 确定断裂表面晶体学取向的电子背散射衍射方法

谢季佳,上官丰收,武晓雷,洪友士

(中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室,北京 100080)

摘 要:利用扫描电镜中带多自由度的样品台和电子背散射衍射系统(BBSD)研究了断口的晶体学定向方法。对于镍拉伸变形后的沿晶断裂表面,利用 BBSD 确定了晶粒与样品坐标之间的晶体学取向关系,通过样品台倾转获得断裂面与样品之间的几何对应关系,从而定出样品沿晶断裂面主要的晶体学位向是{100}。

关键词 : 晶体定向 ;电子背散射衍射 ;断裂面

中图分类号: 073;076;TGI15.23 文献标识码: A

脆性材料的断口常为平直的断裂面,其取向与 样品载荷条件及材料晶体结构相关,确定断裂面的 晶体学位向是研究断裂机制的关键。利用扫描电镜 中电子背散射衍射分析方法并配合具有双倾转功能 的样品台,可确定样品的晶体学取向<sup>[1~6]</sup>。Slavik 等<sup>[1]</sup>的方法涉及样品台两个方向的倾转,实际操作 中稍显复杂。Randle 等<sup>[3~6]</sup>发展的技术为定出断裂 面相对于样品坐标系的取向,需精细抛光样品的剖 面并测量抛光的厚度,制样和测量过程非常费时。 本文工作对上述方法进行了改进,并对镍拉伸样品 的沿晶断口进行了分析。

## 1 实验材料与方法

#### 1.1 实验材料

实验材料为真空退火的电解沉积镍板,厚约 120 µm,平均晶粒尺寸为 232 µm。在退火处理前对 样品做表面抛光处理。退火后的样品做了拉伸实 验,拉伸应变率控制为 10<sup>-4</sup> s<sup>-1</sup>。

#### 1.2 实验设备

扫描电镜为 FEI Sirion 400 NC型,带 5 坐标的自 动样品台。EBSD 系统为 Oxford INCA300 Crystal。角 度测量用的是 Image Pro-Plus 4.5 图像处理软件。

#### 1.3 断裂面晶体定向的方法

在做断裂面晶体学定向之前,先建立样品坐标 和断裂面上的局部坐标。如图 1 所示,局部坐标系 <0>的  $x_3^{<0>}$  轴沿断裂面法向, $x_1^{<0>}$  方向平行于 断裂面与样品上表面的交线。局部坐标系<1>的  $x_3^{<1>}$  轴沿样品上表面法向, $x_1^{<1>}$  轴平行于断裂面 与样品上表面交线。 $x_3^{<1>}$  轴与  $x_3^{<0>}$  轴夹角为 ,  $x_1^{<1>}$  轴与  $x_1^{<0>}$  轴平行。样品坐标系<5>的  $x_3^{<s>}$  轴沿样品上表面法向,与  $x_3^{<1>}$  轴平行。 $x_2^{<>>}$  轴沿 样品横向与  $x_2^{<1>}$  轴夹角为 。晶格坐标系 < C > 则是以晶体的[1,0,0]、[0,1,0]、[0,0,1]三个方向 为基量建立的坐标系,对立方晶系材料是直角坐标 系。有关坐标变换方法,可参照李国琛等的工作<sup>[7]</sup>。

要定出断裂面的晶体学取向,第一步是将断裂 面的法向在样品坐标系中的指数标定出来。这一过 程可以分解为两个步骤: 首先对断裂面法向做局 部坐标 <0>到 <1>的坐标变换,即将坐标系 <0> 以  $x_1^{<0>}$  轴旋转角度 。设断裂面法向为矢量  $\vec{v}$ ,在 局部坐标 <0>中沿[0,0,1]方向,则其变换到坐标 系 <1>的指数由下式确定:

$$\vec{v}^{<1>} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos() & \sin() \\ 0 & -\sin() & \cos() \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
(1)

此处当旋转方向与  $x_1^{<0>}$  之间符合右手法则时, 取正值; 进一步做局部坐标 < 1 > 到样品坐标 <S>的坐标变换,即将坐标系 <1 > 以  $x_3^{<1>}$  轴为 旋转轴转过角度 ,变换后断裂面法向矢量在坐标 系 <S>中的指数为:

$$\vec{v}^{~~} = \begin{bmatrix} \cos(\ ) & \sin(\ ) & 0 \\ -\sin(\ ) & \cos(\ ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \vec{v}^{<1>}~~$$
(2)

此处当旋转方向与 x<sub>5</sub><sup>-1></sup> 之间符合右手法则时, 取 正值。在配备双倾转台的扫描电镜中,可以实验测 得 和 角度值,只需代入公式(2)就可计算得断裂 面法向在样品坐标系的指数。

第二步是利用 EBSD 给出的样品法向(ND) x<sub>3</sub><sup><s></sup> 与轧制方向(RD) x<sub>1</sub><sup><s></sup> 在晶格坐标 < C > 中的 指数,给出样品坐标 < S > 到晶格坐标 < C > 的坐标

作者简介:谢季佳(1973-),男(汉族),湖南省衡阳市人,助理研究员,博士研究生.

收稿日期:2005-05-16;修订日期:2005-08-19



图1 样品坐标系与断裂面局部坐标系。



变换矩阵。首先计算样品横向 (TD) 在晶格坐标中 的指数,显然有  $x_2^{ss} = x_3^{ss} \times x_1^{ss}$ 。设样品坐标 <S>到晶格坐标 <C>的变换矩阵为 C,则有:

$$C = \left[ \frac{x_1^{~~}}{|x_1^{~~}|} \quad \frac{x_2^{~~}}{|x_2^{~~}|} \quad \frac{x_3^{~~}}{|x_3^{~~}|} \right] \quad (3)~~~~~~~~~~~~$$

这里  $x_i^{<c>}$  (*i* = 1,2,3) 对应于 RD、TD、ND 各方 向在晶格坐标 < C > 中的指数构成的列矢量,*C* 是 一个3 ×3 的方阵。要说明的是,这样构造的 *C* 矩阵 对全部七个晶系都有效。但对非立方晶系,由于晶 格坐标系各坐标轴夹角与轴比变化, $x_2^{<>}$  (TD) 方向 指数的求解以及|  $x_i^{<c>}$  (*i* = 1,2,3) 的表达式不仅与 方向指数有关,而且与晶格坐标系的基矢量有关。 本文工作不涉及此类材料,因此不一一列出。对立 方晶系可直接代入方向指数按矢量代数方法求 解。 确定了坐标变换矩阵 *C*,则断裂面的法向最后 表达到晶格坐标中的指数为:

$$\vec{v} = C \cdot \vec{v}^{~~} \tag{4}~~$$

同样,对非立方系材料,还应进一步将 v<sup>2</sup>转化为晶 格坐标的倒易坐标。

通常样品的解理断裂总是沿着某些特殊的低指 数晶面,由于实验角度的测量误差,用上述方法算得 的结果并非与低指数方向完全重合,但只要二者的 夹角不大,可以认定断裂面就是对应的低指数晶面。

### 2 结果与讨论

图 2a 为退火处理后样品的光学金相照片,此时 样品中存在大量的台阶状晶界,在晶内沿平行于台 阶面的方向有第二相粒子析出。X 射线能谱(EDS) 和 EBSD 的研究表明析出的颗粒为 NiS,相。图 2b



图 2 a:样品 650 真空退火后的显微组织;b:样品拉伸后断口的 SEM 形貌像。Bar = 50µm Fig. 2 a: Optical microstructure of Ni annealed at 650 ;b:SEM fracture surface image of Ni sample after tension. Bar = 50µm

为拉伸断口的 SEM 照片,表明断口为台阶状沿晶断口。

图 3 是对断口中一个晶界测量的具体操作过 程。第一步旋转样品台,将待测断面与样品上表面 的交线 AB 旋转至与样品台水平轴平行(图 3a)。第 二步以样品台水平轴为倾转轴做样品台的倾转,直 到测量面与电子束入射方向垂直(图 3b),记录下此 时的倾转角度为 34.3°,对应的 = 34.3°-90°= - 55.7°。图 3c 为 EBSD 系统在样品台倾转 70 时采 集的二次电子像(图像为倾斜校正后采集),图像分 析表明待测断面与样品上表面的交线 AB 线与竖直 线夹角为 40.0°,即 = 40.0°。在该断面附近紧邻 AB 线的区域(图 3c 白色箭头所示的拉伸样品抛光 表面处)做 EBSD 分析.图 3d 为分析区域的 EBSD 花 样和 (001) 极图。EBSD 系统分析给出样品法向 (ND)  $x_3^{<>>}$ 的指数为[15, -11, -3],轧制方向(RD)  $x_1^{<>>}$ 的指数为[4,9, -13]。根据前面所述的方法 计算得该面法向的晶向指数为[-0.032, -0.999, -0.035],与[0, -1,0]方向夹角为 2.7°。表 1 列出 了实验测试的几个断裂面结果,大量的断裂面沿{1, 0,0}晶面,这表明 NiS<sub>2</sub> 在{1,0,0}面的析出导致了材 料的沿晶脆断。

与 Slavik<sup>[1]</sup>的方法相比,本方法的效率要稍高一些。而与 Randle<sup>[2~6]</sup>的方法相比,本方法省却了样品的定量抛光过程,因此更快捷。本方法的不足之处是只能对曝露的断裂面做定向分析,而Randle<sup>[2~6]</sup>的方法还可分析晶界等内部界面。



- 图 3 断裂面晶体学定向过程操作 (Bar = 50µm)。a:旋转样品台使断裂面与样品上表面的交线 AB 平行于样 品台的倾转轴 (图中水平方向);b:倾转样品台使断裂面法向与电子束入射方向垂直,记录倾转角; c: BISD 系统采集的二次电子像,测量得到交线 AB 与 RD 方向的夹角;d:分析点的 EBSD 花样 和对应 的(0,0,1) 极图。
- Fig. 3 Determination for crystal orientation of fracture surface(Bar = 50 µm). a : Rotating the stage to make the trace(line AB) of fracture facet parallel to tilt axis of the stage(horizontal axis in this figure) ;b : Tilting the stage to make the normal direction of fracture facet perpendicular to electron beam direction, and recording the tilt angle; c : Measuring the angle between the trace of fracture facet(line AB) and longitudinal direction in the image acquired by EBSD system; d : EBSD pattern and (0, 0, 1) pole figure of grain adjacent to the fracture facet.

表 1	<u> </u>	几个新刻面参数及标定结!	₽
1 X I	大型川里リル	山口的夜田多奴及你足纪。	不

Table 1 Measurements and the calculated orientations of fracture facets

顺序号			ND 指数	RD 指数	断裂面指数	标定指数
1	- 53 °	70. 2 °	- 7, - 10,11	- 5, - 2, - 5	0.094,0.04,0.995	0,0,1
2	- 55.7°	40.0°	15, - 11, - 3	4,9,-13	- 0.032, - 0.999, - 0.035	0,-1,0
3	- 79 °	43. 2 °	7,-10,1	1,0,-7	- 0.564, - 0.569,0.598	- 1, - 1,1
4	- 85.2 °	96.7°	7,-10,1	1,0,-7	0.002, - 0.001,1	0,0,1
5	- 92 °	55.4°	1,-6,9	9,-6,-5	- 0.993,0.056,0.106	- 1,0,0
6	- 93.3 °	8.4°	- 9,4,1	- 3, - 7,1	- 0.034 ,0.032 , - 0.999	0,0,-1

## 3 结论

对于与样品表面相交的断裂面,利用 EBSD 和 双倾转的样品台,可以在 SEM 中实现晶体学定向。 对含 S 元素偏聚的镍样品拉伸沿晶断口的定向分析 表明,主要断裂面沿{1,0,0}晶面,表明 NiS<sub>2</sub> 的析出 对样品的晶界生长与断裂行为有决定性作用。

#### 参考文献:

 [1] Slavik D C, Wert J A, Gangloff R P. J Mater Res, 1993, 8 (10):2482 - 2491.

- Semprimoschnig C O A, Stampfl J, Pippan R, Kolednik O.
  Fatiure Fract Engng Mater Struct, 1997, 20 (11): 1541 -1550.
- [3] Randle V, Hoile C. Materials Science Forum, 1998, 273 -275:183 - 190.
- [4] Randle V. Journal of Microscopy, 1999, 195:226 232.
- [5] Davies PA, Randle V. Journal of Microscopy ,2001 ,204 :29
   38.
- [6] Davies P A, Novovic M, Randle V, Bowen P. Journal of Microscopy ,2002 ,205 :278 - 284.
- [7] 李国琛,等.塑性大应变微结构力学[M].第二版.北 京:科学出版社,1998.9-10,86.

## Method for determining crystal orientation of fracture facet using electron back-scattering diffraction

XIE Ji-jia ,SHANGGUAN Feng-shou ,WU Xiao-lei ,HONG You-shi

(State Key Laboratory of Nonlinear Mechanics, Institute of Mechanics Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

**Abstract** : A method was proposed to characterize the crystallographic orientation of fracture surface facets in a scanning electron microscope. Firstly, the orientation of grain abutted on the facet was measured relative to the reference axes in Ni sample after tensile testing using electron back-scattering diffraction analysis. Secondly, the inclination of the facet with respect to the same reference axes was determined by using double-tilting stage. Finally, the direction of fracture facet of Ni tension sample was obtained to be {100}. **Keywords** : crystal orientation ;electron back-scatter diffraction(EBSD) ;fracture facet